

講演分科日程表 (分科別) I

埼玉大学

大分類分科名 中分類分科名	3月29日(火)		3月30日(水)		3月31日(木)		4月1日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
本部共通行事								
応用物理学業績賞・研究分野業績賞授賞式		工総-R 19 17:30~18:10						
第5回応用物理学業績賞受賞記念講演/難波進氏			共A-YN 3 9:30~10:20					
第5回応用物理学業績賞受賞記念講演/菅野卓雄氏			工総-S 3 11:00~11:50					
第17回応用物理学講演奨励賞贈呈式	工総-S 4 12:30~13:30							
第6回光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演				共C-YV 2 13:00~13:35				
第2回光・電子集積技術業績賞(林敏雄賞)受賞記念講演	経A-ZR 2 9:30~10:05							
日本光学会総会・光学論文賞授賞式受賞記念講演				経A-ZR 38 13:00~15:05				
世界物理年特別講演会「限界を超える応用物理」		大学-YY 14 14:00~16:00						
特別講演会「学生・院生・研究者のための英語論文講座-日本人が間違えやすい表現」				理3-ZK 16 14:00~16:00				
第36回応用物理学スクールA「最先端医療を支えるテクノロジーの現状と今後の展開」			経B-ZL 15 9:00~17:20					
応用物理学学会評議員会		工総-R 19 16:30~17:30						
懇親会		大学-YY 19 18:30~20:00						
1. 放射線・プラズマエレクトロニクス								
1.1 放射線・加速器・原子炉			教A-H 37 10:00~12:00		教A-H 37 10:00~13:00	教A-H 37 14:00~18:15	教A-H 37 9:00~12:00	
1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源		教A-F 37 14:00~17:30	教A-F 38 10:00~13:00		教A-F 38 9:30~12:00			
1.3 反応性プラズマの診断と計測	教A-H(ショート) 9:15~12:00	→ポスター 38 13:00~15:00						
1.4 プラズマ応用プロセス		教A-G 39 13:00~17:30			教A-G 39 9:15~11:45			
1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー			教A-D 39 9:45~13:00					
1.6 プラズマ現象一般				教A-F 39 14:00~17:00	教A-D 40 9:00~11:45			
2. 計測・制御								
2.1 計測・制御技術							教A-M 40 9:15~12:00	教A-M 40 13:00~15:00
2.2 精密計測・ナノ計測					教A-M 40 10:30~12:30			
2.3 計測標準					教A-M 40 12:30~13:00	教A-M 40 14:00~18:30		
3. 光								
3.1 物理光学・光学基礎							共C-YS 95 9:00~10:15	
3.2 材料光学			経A-ZR 95 9:00~12:00	#経A-ZR 95 13:00~18:15				
3.3 機器・デバイス光学					共C-YT 95 9:00~12:00	共C-YT 95 13:00~17:15		
3.4 計測光学		理2-ZF(ショート) 13:00~14:35 →ポスター 96 15:30~17:30		理2-ZF(ショート) 13:00~14:35 →ポスター 96 15:30~17:30		理2-ZF(ショート) 13:00~14:45 →ポスター 96 15:30~17:30		
3.5 情報光学	共C-YS 97 9:00~12:00		共C-YS 97 9:00~11:45					
3.6 視覚・色彩							共C-YS 97 10:30~12:30	
3.7 生体・医用光学				共C-YS 97 12:15~18:45	共C-YS 98 9:00~12:00			
3.8 近接場光学	総合-YZ 98 9:00~12:00	総合-YZ 98 13:00~17:15	総合-YZ 98 9:15~12:00					
3.9 光学新領域								共C-YS 98 13:30~15:30
4. 量子エレクトロニクス								
4.1 量子光学・原子光学								
4.2 フォトニックナノ構造・現象	共C-YV 99 9:00~12:15	共C-YV 99 13:10~17:40	共C-YV 99 9:00~12:00	##共C-YV 99 13:00~18:05	共C-YV 100 9:00~12:15	共C-YV 100 13:15~17:30		
4.3 レーザー装置・材料	共C-YT 100 9:00~12:00	共C-YT 100 13:30~18:00	共C-YT 101 9:00~12:00	共C-YT 101 13:30~17:15				
4.4 超高速・高強度レーザー	理2-ZF(ショート) 10:30~12:00	→ポスター 101 13:00~15:00	理2-ZF(ショート) 10:30~11:50	→ポスター 102 13:00~15:00	理2-ZF(ショート) 10:30~11:50	→ポスター 102 13:00~15:00		
4.5 非線形光学			工情-W 102 9:30~12:30	工情-W 103 13:30~18:00	工情-W 103 9:00~12:45	工情-W 103 13:45~19:00	工情-W 104 9:00~11:15	
4.6 レーザー分光応用・計測	共C-YR 104 9:00~12:00	共C-YR 104 13:00~15:45						
4.7 レーザー・プロセッシング			共C-YR 104 9:00~12:00	共C-YR 104 13:00~18:45	共C-YR 105 9:00~12:00	共C-YR 105 13:00~18:30		

会場名の前は、号館を表示(例:工総-Rは工学部総合研究棟のR会場)
 # 光学論文賞受賞記念講演があります。
 ## 第6回光・量子エレクトロニクス業績賞受賞記念講演があります。
 シンポジウム12頁参照

【講義棟略称】

共通教育A棟→共A
 教育学部A棟→教A
 理学部2号館→理2
 工学部講義棟・情報メディア基盤センター→工講
 工学部建設工学科棟→工建
 工学部総合研究棟→工総
 総合研究機構棟→総合

教養学部棟→教養
 経済学部A棟→経A
 理学部C棟→理C
 工学部電気電子システム工学科棟→工電
 工学部情報工学科棟・理工学研究科棟→工情
 大会館→大会

講演分科日程表 (分科別) II

埼玉大学

大分類分科名 中分類分科名	3月29日(火)		3月30日(水)		3月31日(木)		4月1日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
5. 光エレクトロニクス								
5.1 半導体レーザー・発光素子	理C-ZH 105 9:30~12:30				理C-ZH 106 9:30~12:30	理C-ZH 106 13:30~18:00		
5.2 光検出						教A-D(ショート) 12:20~12:45 →ポスター 106 15:30~17:30		
5.3 光記録							理C-ZH 106 9:00~12:30	
5.4 光制御	経A-ZQ 107 9:30~12:30 #経A-ZR 107 9:30~12:05	経A-ZQ 107 13:30~17:30	経A-ZQ 107 9:00~12:00	経A-ZQ 107 13:00~18:30	経A-ZQ 108 9:30~12:30	経A-ZQ 108 13:30~19:00	経A-ZQ 108 9:00~12:30	経A-ZQ 109 13:30~14:45
5.5 光ファイバー						教A-D(ショート) 13:00~15:00 →ポスター 109 15:30~17:30		
6. 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜	P1 67 9:30~11:30	工情-T 67 13:00~13:15	P2 67 9:30~11:30		P4 68 9:30~11:30			
6.2 カーボン系薄膜	工建-Q 68 10:00~13:00	工建-Q 68 14:00~16:45	工建-Q 69 10:00~13:15	工建-Q 69 14:15~18:45	工建-Q 69 10:00~13:00	工建-Q 69 14:00~17:00		
6.3 酸化物エレクトロニクス	教A-K 70 10:00~13:00	教A-K 70 14:00~17:45	教A-K 70 10:00~13:00	教A-K 70 14:00~18:45	教A-K 71 10:00~13:00	教A-K 71 14:00~19:00		
6.4 薄膜新材料	教A-C 71 10:00~12:45		教A-C 72 10:00~12:45	教A-C 72 14:00~18:30	教A-C 72 10:00~12:45	教A-C 72 14:00~18:00	教A-C 73 9:00~11:15	
6.5 表面物理・真空	教A-B 73 10:00~13:00	教A-B 73 14:00~17:30	教A-B 73 10:00~13:00		教A-B 73 10:00~13:00	教A-B 74 14:00~18:30	教A-B 74 10:00~11:45	
6.6 プローブ顕微鏡			共C-YQ 74 9:00~12:00	共C-YQ 74 13:00~18:45	共C-YQ 75 9:00~12:00	共C-YQ 75 13:00~18:45		
7. ビーム応用								
7.1 X線技術	教養-YX 75 9:00~12:00				教養-YX 75 9:00~12:00	教養-YX 76 13:00~18:45		
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析							共C-YV 76 9:00~12:00	共C-YV 76 13:00~15:15
7.3 リソグラフィ	教養-YW 77 9:00~12:00		教養-YW 77 9:00~12:00	教養-YW 77 13:00~18:00	教養-YW 77 9:00~12:00	教養-YW 78 13:00~17:45		
7.4 ビーム励起表面反応							共C-YT 78 9:00~12:15	共C-YT 78 13:15~15:30
7.5 イオンビーム一般	共A-YN 78 9:00~12:00	共A-YN 79 13:00~17:15	##共A-YN 79 9:30~11:30					
7.6 プラズマ・イオン・光プロセス								
7.7 微小電子源				工情-V(ショート) 13:00~14:40 →ポスター 79 15:30~17:30		工情-V(ショート) 13:00~13:50 →ポスター 79 15:30~17:30		
7.8 ビーム応用一般・新技術		経B-ZL 80 13:30~14:45						
8. 応用物性								
8.1 磁性材料・磁気デバイス	共A-YC 41 9:00~12:00	共A-YC 41 13:00~14:45						
8.2 誘電材料・誘電体			工情-T 41 9:30~12:30	工情-T 41 13:30~19:00				
8.3 微粒子・粉体	教A-A 41 10:00~13:00	教A-A 42 14:00~16:15						
8.4 ナノエレクトロニクス					工情-T 42 9:30~12:30			
8.5 熱電変換					教A-A 42 9:00~13:00	教A-A 42 14:00~18:00	教A-A 43 9:00~12:00	教A-A 43 13:00~15:00
8.6 新機能材料・新物性			教A-A 43 10:00~12:15					
9. 超伝導								
9.1 基礎物性			工講-ZD 43 9:45~12:30		工電-X 43 9:00~12:00	工電-X 44 13:00~18:00		
9.2 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス	理2-ZG 44 9:00~12:00							
9.3 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	工講-ZA 44 9:00~12:15		工講-ZA 44 9:15~12:30					
9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用				工講-ZA(ショート) 13:00~14:55 →ポスター 45 15:30~17:30				
9.5 アナログ応用および関連技術					工講-ZA 45 9:30~12:15	工講-ZA 45 13:30~19:15		
9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	工電-X 46 9:30~12:30		工電-X 46 9:30~12:30	工電-X 46 13:30~17:45				

注: P1-P6はポスターセッションのみ。(場所は体育館)
会場名の前は, 号館を表示(例: 理C-ZHは理学部C棟のZH会場)
第2回光・電子集積技術業績賞受賞記念講演があります。
第5回応用物理学学会業績賞(研究業績)受賞記念講演があります。
シンポジウム12頁参照

【講義棟略称】

共通教育A棟→共A
教育学部A棟→教A
理学部2号館→理2
工学部講義棟・情報メディア基盤センター→工講
工学部建設工学科棟→工建
工学部総合研究棟→工総
総合研究機構棟→総合

教養学部棟→教養
経済学部A棟→経A
理学部C棟→理C
工学部電気電子システム工学科棟→工電
工学部情報工学科棟・理工学研究科棟→工情
大会館→大学

講演分科日程表 (分科別) III

埼玉大学

大分類分科名 中分類分科名	3月29日(火)		3月30日(水)		3月31日(木)		4月1日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
10. 有機分子・バイオエレクトロニクス								
10.1 作製技術	共A-YM 109 9:00~12:00	共A-YM 109 13:00~17:30	共A-YM 110 9:00~12:00	共A-YM 110 13:00~17:30				
10.2 評価・基礎物性	共A-YB 110 9:00~12:15	共A-YB 110 13:15~17:15	共A-YB 111 9:00~12:30	共A-YB 111 13:30~18:15				
10.3 電子機能材料・デバイス		教A-D(ショート) 13:05~15:00 →ポスター 111 15:30~17:30		教A-D(ショート) 13:00~15:00 →ポスター 112 15:30~17:30				
10.4 光機能材料・デバイス					共A-YB 112 9:00~12:00	共A-YB 112 13:00~18:00	共A-YB 113 9:00~12:00	共A-YB 113 13:00~14:45
10.5 液晶					共A-YM 113 9:00~12:00	共A-YM 113 13:00~18:45		
10.6 高分子・ソフトマテリアル						工講-ZC 114 13:30~17:30		
10.7 生物・医用工学・バイオチップ					共A-YN 114 9:00~18:45	共A-YN 114 9:00~12:00	共A-YN 115 13:00~18:45	共A-YN 115 9:00~12:00
10.8 有機EL					共A-YL 115 13:00~17:15	共A-YG 116 9:00~12:00	共A-YG 116 13:00~17:15	共A-YG 116 9:00~12:15
10.9 特定テーマA:有機トランジスタ	共A-YG 116 9:15~12:00	共A-YG 117 13:00~17:30	共A-YG 117 9:00~12:00		大学-YY 117 9:00~12:00	大学-YY 117 13:00~15:15		
10.10 特定テーマB:分子・バイオナノテクノロジー	共A-YL 117 9:00~12:00	共A-YL 118 13:00~17:30	共A-YL 118 9:15~12:00		共A-YL 118 9:30~12:00	共A-YL 118 13:00~16:45		
11. 半導体A (シリコン)								
11.1 基礎物性・評価			工講-ZC 80 9:30~12:30	工講-ZC 80 13:30~17:30				
11.2 半導体表面	工講-ZC 80 9:30~12:30	工講-ZC 80 13:30~16:45						
11.3 絶縁膜技術	工講-ZB 81 9:30~12:30	工講-ZB 81 13:30~18:00	工講-ZB 81 9:30~12:30	工講-ZB 81 13:30~18:30	工講-ZB 82 9:30~12:30	工講-ZB 82 13:30~18:30	工講-ZB 83 9:00~12:30	工講-ZB 83 13:30~15:00
11.4 配線技術			工講-ZE 83 9:30~12:00	##工講-ZE 83 13:00~17:30	工講-ZE 83 9:30~12:30	工講-ZE 84 13:30~18:45	工講-ZE 84 9:30~12:15	
11.5 Si プロセス技術	工総-R 84 9:30~12:30		工総-R 84 9:30~11:30		共A-YE 84 9:00~12:15	共A-YE 85 13:30~18:45	共A-YE 85 9:00~12:00	共A-YE 85 13:00~15:00
11.6 Si デバイス/集積化技術			#工総-S 86 9:30~11:50		P5 86 9:30~11:30		P6 86 9:30~11:30	
11.7 シミュレーション						工講-ZD 87 13:30~17:00		
12. 半導体B (探索的材料・物性・デバイス)								
12.1 探索的材料物性					共A-YC 119 9:00~12:00	※共A-YC 119 13:00~18:00	共A-YC 119 9:00~12:00	共A-YC 119 13:00~14:45
12.2 超薄膜・量子ナノ構造		工情-V(ショート) 13:15~15:05 →ポスター 120 15:30~17:30	工情-V(ショート) 9:00~12:00	→ポスター 120 13:00~15:00	工情-V(ショート) 9:00~11:55	→ポスター 121 13:00~15:00		
12.3 プロセス技術・界面制御				※共A-YC 121 13:00~17:45				
12.4 超高速・機能デバイス					※工総-S 122 9:00~12:30	工総-S 122 13:30~16:45	工総-S 122 9:00~12:00	工総-S 122 13:00~15:00
12.5 半導体光物性・光デバイス	共A-YK 123 9:00~12:30		共A-YK 124 9:00~12:15		経A-ZR 124 9:00~11:45	工情-T 124 13:00~17:30	共A-YH 125 9:45~12:00	
	共A-YH 123 9:00~12:30	共A-YH 123 13:30~17:30	共A-YH 123 9:30~12:30	※共A-YH 124 13:30~18:15	共A-YH 125 9:00~12:00	共A-YH 125 13:00~17:15		
13. 結晶工学								
13.1 バルク結晶成長			経A-ZN 47 10:30~12:30	経A-ZN 47 13:30~17:15				
13.2 II-VI 族結晶					経A-ZN 47 9:30~12:30	経A-ZN 47 13:30~18:00	経A-ZN 48 9:00~12:00	経A-ZN 48 13:00~15:00
13.3 III-V 族エピタキシャル結晶		経A-ZM 48 15:30~17:45	経A-ZM 48 9:30~12:30	経A-ZM 48 13:30~18:30	経A-ZM 49 9:30~12:30	経A-ZM 49 13:30~18:00	経A-ZM 49 9:00~12:00	
13.4 III-V 窒化物結晶	教C-N(ショート) 9:00~12:00	→ポスター 50 13:00~15:00	教A-L(ショート) 9:00~12:00	→ポスター 51 13:00~15:00	教A-L(ショート) 9:00~12:00	→ポスター 52 13:00~15:00	教C-N 53 9:00~12:00	教C-N 53 13:00~15:15
		教C-N 50 15:30~17:45		教A-L 51 14:30~18:15		教A-L 52 14:30~18:15		
13.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶					経B-ZL 53 9:30~12:30	経B-ZL 53 13:30~16:00		
13.6 IV 族系化合物				共A-YK 53 12:45~18:45	共A-YK 54 9:00~12:00		共A-YK 54 9:00~12:00	共A-YK 54 13:00~15:00
13.7 エピタキシーの基礎	経A-ZM 54 9:30~12:30	経A-ZM 55 13:30~15:15						
13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	経A-ZN 55 9:30~12:30	経A-ZN 55 13:30~17:15						

注:P1-P6はポスターセッションのみ。(場所は体育館)
会場名の前は、号館を表示(例:共A-YMは共通教育A棟のYM会場)
第5回応用物理学学会業績賞(研究業績)受賞記念講演があります。
分科内総合講演:「65nm~45nmを目指したCu/Low-k多層配線技術」
※分科内招待講演があります。
シンポジウム12頁参照

【講義棟略称】
共通教育A棟→共A
教育学部A棟→教A
理学部2号館→理2
工学部講義棟・情報メディア基盤センター→工講
工学部建設工学科棟→工建
工学部総合研究棟→工総
総合研究機構棟→総合
教養学部棟→教養
経済学部A棟→経A
理学部C棟→理C
工学部電気電子システム工学科棟→工電
工学部情報工学科棟・理工学研究科棟→工情
大学会館→大学

講演分科日程表（分科別）IV

埼玉大学

大分類分科名 中分類分科名	3月29日(火)		3月30日(水)		3月31日(木)		4月1日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
14. 非晶質・微結晶								
14.1 基礎物性・評価		理2-ZG 87 13:00~16:45	理2-ZG 88 9:30~12:30	理2-ZG 88 16:30~17:30	理2-ZG 88 9:30~12:30			
14.2 プロセス技術			教C-N 88 9:30~12:30	#理2-ZG 88 13:30~16:15	教C-N 89 9:30~12:15			
14.3 デバイス		教A-E 89 16:30~17:45						
15. 応用物理一般								
15.1 応用物理一般					工講-ZD 55 9:30~12:10			
15.2 教育			P3 55 9:30~11:30					
15.3 新技術					共A-YA 56 9:00~11:45			
15.4 トライボロジー						共A-YA 56 13:00~14:00		
15.5 エネルギー変換・貯蔵						共A-YA 56 14:00~16:45		
15.6 資源・環境			共A-YA 57 10:00~11:45					
15.7 磁場応用	共A-YA 57 10:00~12:45	共A-YA 57 14:15~17:30	理3-ZK 57 10:00~13:00					
合同セッション								
合同セッションD「プラズマCVDの基礎と応用」	教A-E 57, 89 9:00~12:00	教A-E 58, 89 13:00~16:30						
合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	共A-YD 58, 125 9:00~12:00	共A-YD 58, 125 13:00~17:30	共A-YD 58, 126 9:00~12:00		共A-YD 59, 126 9:00~12:00	共A-YD 59, 126 13:00~18:15	共A-YD 59, 127 9:00~12:00	共A-YD 59, 127 13:00~15:00
合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	共A-YF 60, 89, 127 9:00~12:00	*共A-YF 60, 90, 127 13:00~17:45	共A-YE 60, 90, 128 9:00~12:00		共A-YF 61, 91, 128 9:00~11:45	共A-YF 61, 91, 129 12:45~18:15	共A-YF 62, 91, 129 9:00~11:45	共A-YF 62, 92, 129 12:45~15:15
合同セッションG「量子情報の基礎と応用」	理3-ZK 62, 129 9:30~12:30	##理3-ZK 62, 130 13:30~16:45			共A-YF 60, 90, 128 9:00~11:45	共A-YF 61, 90, 128 13:00~18:15		理3-ZK 62, 130 13:30~16:15
合同セッションH「プラズマエッチングのデバイス応用とその基礎」	工講-ZE 63, 92 9:00~12:30	###工講-ZE 63, 92 13:30~17:30	教A-G 63, 92 9:00~12:30					
合同セッションJ「センサー技術の発展と応用」	教A-M 63, 130 10:00~13:00	教A-M 64, 130 14:00~17:40	教A-M 64, 131 10:00~12:40					
合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」			教A-E 64, 93 10:00~13:00	教A-E 64, 93 14:00~18:15	教A-E 65, 93 9:30~13:00			

注：P1-P6 はポスターセッションのみ。（場所は体育館）
 会場名の前は、号館を表示（例：理2-ZG は理学部2号館のZG会場）
 #分科内総合講演：「酸化物ガラスのプロセス技術：最近の進展とこれからの課題」
 ##分科内総合講演：「量子暗号及び単一光子生成技術」
 ###分科内総合講演：「MEMSデバイスと加工技術」
 ※分科内招待講演があります。
 シンポジウム12頁参照

【講義棟略称】

共通教育A棟→共A
 教育学部A棟→教A
 理学部2号館→理2
 工学部講義棟・情報メディア基盤センター→工講
 工学部建設工学科棟→工建
 工学部総合研究棟→工総
 総合研究機構棟→総合
 教養学部棟→教養
 経済学部A棟→経A
 理学部C棟→理C
 工学部電気電子システム工学科棟→工電
 工学部情報工学科棟・理工学研究科棟→工情
 大学会館→大学

講演分科日程表について (例)

3月29日(火)		3月30日(水)		3月31日(木)		4月1日(金)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
教A-H(ショート) 9:00~11:55	→ポスター12 13:00~15:00	P1 22 9:00~11:30	共A-YE 23 13:00~19:00	工総-R 25 9:00~12:00	工総-R 26 13:00~18:00	工総-R 28 9:00~12:00	
amがショート講演, pmがポスターセッションの例		ポスターセッションのみ		場所の略記号(共通教育A棟, YE会場)		講演時間	
						プログラム掲載頁	

日程表 (会場別) I

埼玉大学

会場	収容数	3月29日(火)		3月30日(水)		3月31日(木)		4月1日(金)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
教育学部A棟	A 2F-21	87	8.3 微粒子・粉体	8.3 微粒子・粉体	8.6 新機能材料・新物性	「ナノ構造制御による高性能熱電変換材料の創製～理論、プロセス、計測～」	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換
	B 3F-30	95	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	「低エネルギー電子顕微鏡と光電子顕微鏡の新たな展望」	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空
	C 3F-31	142	6.4 薄膜新材料	「固体における水素の計測と制御」～気相から固相、及び固相内での水素の移動を支配しているものは何か～」	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料
	D 3F-32	86		10.3 電子機能材料・デバイス	1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー	10.3 電子機能材料・デバイス	1.6 プラズマ現象一般	5.2 光検出 5.5 光ファイバー		
	E 3F-33	87	合同セッションD「プラズマCVDの基礎と応用」	合同セッションD「プラズマCVDの基礎と応用」 14.3 デバイス	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」			
	F 3F-35	83		1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	1.6 プラズマ現象一般	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源			
	G 3F-36	91		1.4 プラズマ応用プロセス	合同セッションH「プラズマエッチングのデバイス応用とその基礎」	「分子空間ダイナミクスによる機能性材料の創製」	1.4 プラズマ応用プロセス			
	H 3F-37	97	1.3 反応性プラズマの診断と計測		1.1 放射線・加速器・原子炉	「加速器を利用した化学・生物学・医学の最先端」	1.1 放射線・加速器・原子炉	1.1 放射線・加速器・原子炉	1.1 放射線・加速器・原子炉	1.1 放射線・加速器・原子炉
	K 4F-40	137	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス		
	L 4F-41	144			13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶		
M 4F-42	87	合同セッションJ「センサー技術の発展と応用」	合同セッションJ「センサー技術の発展と応用」	合同セッションJ「センサー技術の発展と応用」	「衝撃科学とその応用研究」	2.2 精密計測・ナノ計測 2.3 計測標準	2.1 計測・制御技術	2.1 計測・制御技術	2.1 計測・制御技術	
N 1F-1	312	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶	14.2 プロセス技術	「保護膜、バリア膜形成技術の現状と将来展望」	14.2 プロセス技術	「大気圧プラズマの中身を探索～薬過程、計測・診断とシミュレーション～」	13.4 III-V 窒化物結晶	13.4 III-V 窒化物結晶	
工学部基礎	Q 2F-32	121	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	
工学部総合科学研究棟	R 1F シアター教室	167	11.5 Siプロセス技術	応用物理学会業績賞・研究分野業績賞授賞式	11.5 Siプロセス技術	「レーザー結晶化の新展開」	「エレクトロニクスの10年後を論じる - JST 戦略セッション -」			
	S 2F-11	186	第17回応用物理学会講演奨励賞贈呈式		11.6 Siデバイス/集積化技術 第9回応用物理学会業績賞受賞記念講演	「シリコンナノエレクトロニクスの新展開 - ポストスケールリングテクノロジー -」	12.4 超高速・機能デバイス	12.4 超高速・機能デバイス	12.4 超高速・機能デバイス	12.4 超高速・機能デバイス
工学部情報科学棟・理工学研究所棟	T 1F-61	103		6.1 強誘電体薄膜	8.2 誘電材料・誘電体	8.2 誘電材料・誘電体	8.4 ナノエレクトロニクス	12.5 半導体光物性・光デバイス		
	V 2F-62	103		12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	7.7 微小電子源	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	7.7 微小電子源		
	W 7F 国際セミナー室	123	「テラヘルツ波による化学・バイオ・電子材料評価の最前線」		4.5 非線型光学	4.5 非線型光学	4.5 非線型光学	4.5 非線型光学	4.5 非線型光学	
工学部基礎棟	X 1F-41	124	9.6 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	「超伝導分科会企画：「パワー応用に向けた超伝導材料の新展開」」	9.6 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	9.6 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	9.1 基礎物性	9.1 基礎物性		
	ZA 1F-50	88	9.3 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長		9.3 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	9.4 臨界電流、超伝導パワー応用	9.5 アナログ応用および関連技術	9.5 アナログ応用および関連技術		
工学部講義棟・情報メディア基礎センター	ZB 1F-51	122	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	
	ZC 2F-52	88	11.2 半導体表面	11.2 半導体表面	11.1 基礎物性・評価	11.1 基礎物性・評価	10.6 高分子・ソフトマテリアル			
	ZD 3F-54	88	「半導体プロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション」		9.1 基礎物性	「本気でとらむ男女共同参画 -ワーク・アンド・ライフ・バランスを考える-」	15.1 応用物理一般	11.7 シミュレーション		
	ZE 4F-55	163	合同セッションH「プラズマエッチングのデバイス応用とその基礎」	分科内総合講演「MEMSデバイスと加工技術」 合同Hプラズマエッチングのデバイス応用とその基礎」	11.4 配線技術	分科内総合講演「65nm～45nmを目標としたCu/Low-k 多層配線技術」	11.4 配線技術	11.4 配線技術	11.4 配線技術	
	ZF 2F-8	88	4.4 超高速・高強度レーザー	3.4 計測光学	4.4 超高速・高強度レーザー	3.4 計測光学	4.4 超高速・高強度レーザー	3.4 計測光学		
理学部2号館	ZG 2F-9	119	9.2 新材料、新薄膜、新低温動作デバイス	14.1 基礎物性・評価	14.1 基礎物性・評価	14.1 基礎物性・評価	14.1 基礎物性・評価			
	ZH 1F-1	144	5.1 半導体レーザー・発光素子	「波長集積・操作フォトリソグラフィ光源の進展とこれからの課題」 (IV) -」	「新世代光通信へのイノベーション - 革新的な光デバイスを基点として -」	5.1 半導体レーザー・発光素子	5.1 半導体レーザー・発光素子	5.3 光記録		
理学部3号館	ZK 2F-11	115	合同セッションG「量子情報の基礎と応用」	分科内総合講演「量子暗号及び単一光子生成技術」	15.7 磁場応用	特別講演会「学生・院生・研究者のための英語論文講座 - 日本人が間違えやすい表現」	合同セッションG「量子情報の基礎と応用」			
	ZL 2F-201	192	「物理系3学会及び日本化学会共同企画シンポジウム「これからの物理教育・科学教育 - 「科学へ若者の意欲を高めよう」 -」	7.8 ビーム応用一般・新技術	第36回応用物理学会スクールA「最先端医療を支えるテクノロジーの現状と今後の展開」	13.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶	13.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶			

日程表 (会場別) 2

埼玉大学

会場	収容数	3月29日(火)		3月30日(水)		3月31日(木)		4月1日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
経済学部A棟	ZM 3F-303	96	13.7 エピタキシーの基礎	13.7 エピタキシーの基礎	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶
	ZN 3F-304	96	13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	13.1 パルク結晶成長	13.1 パルク結晶成長	13.2 II-VI 族結晶	13.2 II-VI 族結晶	13.2 II-VI 族結晶
	ZQ 4F-405	132	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御
	ZR 5F-504	192	第2回光・電子集積技術業績賞(林蔵雄賞)受賞記念講演 5.4 光制御	「歩みを始めた分極反転光デバイス」	3.2 材料光学	日本光学会総会・光学論文賞授賞式受賞記念講演 3.2 材料光学	12.5 半導体光物性・光デバイス	「結晶工学分科会, 放射線分科会共同企画「シンチレーター結晶の進歩と課題」	
共通教育A棟	YA 1F-101	80	15.7 磁場応用	15.7 磁場応用	15.6 資源・環境	「技術者への環境教育～人材育成の新展開～」	15.3 新技術	15.4 トライボロジー 15.5 エネルギー変換・貯蔵	
	YB 1F-102	134	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス
	YC 1F-103	80	8.1 磁性材料・磁気デバイス	8.1 磁性材料・磁気デバイス		12.3 プロセス技術・界面制御	12.1 探索的材料物性	12.1 探索的材料物性	12.1 探索的材料物性
	YD 1F-104	180	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	「スピンの制御と検出の最前線」	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」
	YE 1F-106	283		「半導体ナノワイヤの新展開」	合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	「光技術と技術経営—国際競争力回復を目指して—」	11.5 Siプロセス技術	11.5 Siプロセス技術	11.5 Siプロセス技術
	YF 2F-202	285	合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」
	YG 2F-204	284	10.9 特定テーマA: 有機トランジスタ	10.9 特定テーマA: 有機トランジスタ	10.9 特定テーマA: 有機トランジスタ	「有機電子デバイス—実用化の鍵を握る界面の構造と機能」	10.8 有機EL	10.8 有機EL	10.8 有機EL
	YH 2F-206	180	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス
	YK 3F-301	444	12.5 半導体光物性・光デバイス	「多元系機能材料で創生される光物性と光デバイス—最近の成果と新しい方向性—」	12.5 半導体光物性・光デバイス	13.6 IV 族系化合物	「SiCパワーデバイス—大容量チップ実現に向けてのマイルストーン」	13.6 IV 族系化合物	13.6 IV 族系化合物
	YL 3F-302	123	10.10 特定テーマB: 分子・バイオナノテクノロジー	10.10 特定テーマB: 分子・バイオナノテクノロジー	10.10 特定テーマB: 分子・バイオナノテクノロジー	10.8 有機EL	10.10 特定テーマB: 分子・バイオナノテクノロジー	10.10 特定テーマB: 分子・バイオナノテクノロジー	
YM 3F-303	98	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.5 液晶	10.5 液晶		
YN 3F-304	178	7.5 イオンビーム一般	7.5 イオンビーム一般	第5回応用物理学会業績賞受賞記念講演 7.5 イオンビーム一般	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	
共通教育C棟	YQ 2F-201	165	「薄膜・表面物理分科会企画「プローブ顕微鏡の新展開」に向けて: 現状と未来・可能性」		6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	
	YR 3F-301	117	4.6 レーザー分光応用・計測	4.6 レーザー分光応用・計測	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	
	YS 3F-302	117	3.5 情報光学	「バイオインスパイアード情報フォトニクス」	3.5 情報光学	3.7 生体・医用光学	3.7 生体・医用光学	「光コヒーレントモグラフィ(OCT)の現状と新展開」	3.1 物理光学・光学基礎 3.6 視覚・色彩
	YT 4F-401	117	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	3.3 機器・デバイス光学	3.3 機器・デバイス光学	7.4 ビーム励起表面反応
	YV 5F-501	117	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	第6回光・量子エレクトロニクス業績賞(毛岡宏彰)受賞記念講演 4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析
教養学部棟	YW 1F-10	120	7.3 リソグラフィ	「自由度の高い3次元ナノ構造の創製と応用」	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ	
	YX 1F-11	120	7.1 X線技術	「X線結像光学の新展開」	「X線・中性子による quick 反射率法の展望 - 表面や埋もれたナノ構造の変化を追う」	7.1 X線技術	7.1 X線技術	7.1 X線技術	
大学会館	YY 3F-大集会堂	250		世界物理年特別講演会「限界を超える応用物理」		「バイオ共役ナノマテリアルの新潮流」	10.9 特定テーマA: 有機トランジスタ	10.9 特定テーマA: 有機トランジスタ	
総合棟	YZ 7F-大会議室	150	3.8 近接場光学	3.8 近接場光学	3.8 近接場光学	「ナノフォトニクスの基礎: さらなる新規機能とシステム応用のために」	「ランダム系フォトエレクトロニクス「ナノ粒子分散系」		
第一体育館	ポスターセッション	6.1 強誘電体薄膜②	[前半]	1.3 反応性プラズマの診断と計測② 4.4 超高速・高強度レーザー② 13.4 III-V 窒化物結晶①	[前半]	4.4 超高速・高強度レーザー② 12.2 超薄膜・量子ナノ構造② 13.4 III-V 窒化物結晶①	[前半]	4.4 超高速・高強度レーザー② 12.2 超薄膜・量子ナノ構造② 13.4 III-V 窒化物結晶①	
			[後半]	3.4 計測光学① 10.3 電子機能材料・デバイス① 12.2 超薄膜・量子ナノ構造②	[後半]	3.4 計測光学① 7.7 微小電子源② 9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用① 10.3 電子機能材料・デバイス②	[後半]	3.4 計測光学① 5.2 光検出② 5.5 光ファイバー② 7.7 微小電子源②	
総合体育館				6.1 強誘電体薄膜② 15.2 教育①		6.1 強誘電体薄膜② 11.6 Si デバイス/集積化技術①		11.6 Si デバイス/集積化技術①	